	<h2>SIHA2N80E-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIHA2N80E-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CHAN 800V TO-220 FULLPA</p> <p>Datenblätter:  SIHA2N80E-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	



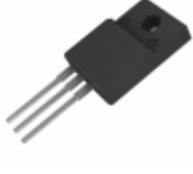
Spezifikationen

Teilenummer	SIHA2N80E-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CHAN 800V TO-220 FULLPA
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220 Full Pack
Serie	E
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.75 Ohm @ 1A, 10V
Verlustleistung (max)	29W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Andere Namen	SIHA2N80E-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	315pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	19.6nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 2.8A (Tc) 29W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.8A (Tc)

SIHA2N80E-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHA2N80E-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHA2N80E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIHA2N80E-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIHA6N65E-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHANNEL 650V 7A TO220</p>	 <p>SIHA25N50E-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 26A TO-220FP</p>	 <p>SIHA6N80E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 800V TO-220FP</p>	 <p>SIHA6N65E-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 650V 7A TO220</p>
 <p>SIHA25N60EFL-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHANNEL 600V 25A TO220</p>	 <p>SIHA25N60EFL-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 25A TO220</p>	 <p>SIHA25N50E VB SIHA25N50E VB</p>	 <p>SIHA4N80E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 800V FP TO-220</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHA2N80E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIHA2N80E-GE3 Datenblatt	SIHA2N80E-GE3-Datenblätter	SIHA2N80E-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIHA2N80E-GE3
SIHA2N80E-GE3 Electronic	SIHA2N80E-GE3-Komponenten	SIHA2N80E-GE3-Verteiler	SIHA2N80E-GE3-Bild	SIHA2N80E-GE3-Teil
SIHA2N80E-GE3 Preis	SIHA2N80E-GE3 Hersteller	SIHA2N80E-GE3 Bild	SIHA2N80E-GE3 Aktie	SIHA2N80E-GE3 Inventar
SIHA2N80E-GE3 Neu	SIHA2N80E-GE3 Original	SIHA2N80E-GE3 garantiert	SIHA2N80E-GE3 RFQ	SIHA2N80E-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited